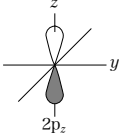
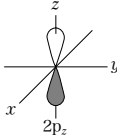
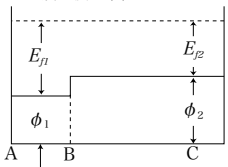
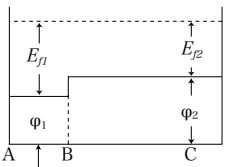


これからスタート！ 電気電子材料 正誤表

コード 30049-7 第1版第1刷(2010/9/2 現在)

ページ	誤	正
1	下から7行目 $h=6.626 \times 10^{34}[\text{J}\cdot\text{sec}]$	$h=6.626 \times 10^{34}[\text{Jsec}]$
14	図2.3.2 一番右の図 	
33	2行目 このとき熱伝導率は次の・・・	このとき熱伝導率Kは次の・・・
33	5行目 Kの単位は[W/m・deg]である。	Kの単位は[W/m・K]である。
58	図7.1.3 2種の金属の接触(c) 	
68	演習問題8.4 演習問題8.5 $10^4[\text{O/m}]$ および $10^2[\text{O/m}]$	$10^4[\text{S/m}]$ および $10^2[\text{S/m}]$
70	(8.2.6)式 $J(V) = J_e(V) + J_h(V) = (J_{er} + J_{hr}) \left[\exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1 \right]$	$J(V) = J_e(V) + J_h(V) = (J_{er}(0) + J_{hr}(0)) \left[\exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1 \right]$
80	図9.2.6 LPE成長膜断面図 n-GaAs基板結晶	n-GaAs基板結晶
81	図9.2.7 MOCVD装置の概略図 (一番上のラインへ流れ込むガスである) AsH_3	(一番上のラインへ流れ込むガスである) AsH_3
84	下から4行目 x が十分大きくて $N(x) = N_s$ のときは	x が十分大きくて $N(x) \ll N_s$ のときは
151	表12.4.2 $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ の $T_c = 110[\text{K}]$	$\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ の $T_c = 90[\text{K}]$
151		表12.4.2 上記の $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ の $T_c = 90[\text{K}]$ の下に $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_8$ の $T_c = 110[\text{K}]$ を追加
181	(b)キャプション (b) 対称中心なし、圧電性を持つもの	(b) 対称中心なし、圧電性を持つ
240	解答8.3(1) $\dots = 16 \times 10^{10}[\text{m}] = 16[\text{nm}]$	$\dots = 16 \times 10^{10}[\text{m}] = 16[\text{nm}]$